

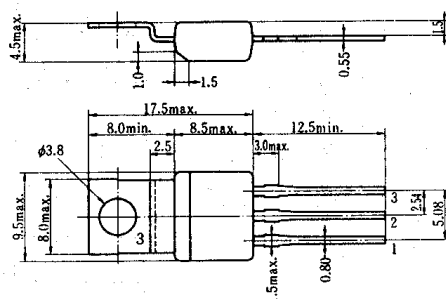
2SC2278

シリコン NPN 三重拡散形

高周波高電圧増幅用
TV 映像出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER
TV VIDEO OUTPUT



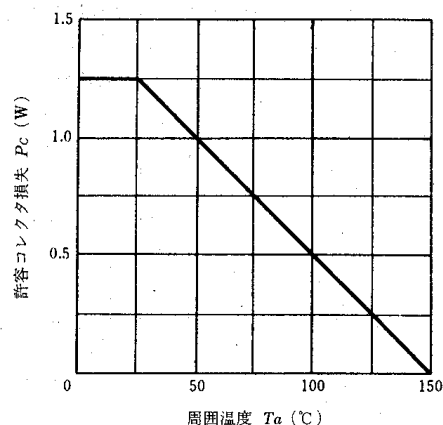
1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-202AA MOD.)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SC2278	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CBO}	300	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	300	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EB0}	5	V
コレクタ電流		I_C	100	mA
ベース電流		I_B	50	mA
許容コレクタ損失		P_C	1.25	W
接合部温度		T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CEO}	$V_{CE}=250\text{V}$, $R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=20\text{mA}$, $I_B=2\text{mA}$	—	—	1.5	V
直流電流増幅率		h_{FE}	$V_{CE}=20\text{V}$, $I_C=20\text{mA}$	30	—	200	
利得帯域幅積		f_T	$V_{CE}=20\text{V}$, $I_C=20\text{mA}$	50	80	—	MHz
逆伝達容量		C_{re}^*	$V_{CB}=20\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$, Emitter ground	—	2	3	pF

*エミッタ端子はアースに接続する。

*Emitter lead is grounded.